

## **Analysis of deep level centers in GaAs pin-diode structures**

**Korolkov, Oleg; Toompuu, Jana; Rang, Toomas** Elektronika ir elektrotehnika = Electronics and electrical engineering 2013 / [4 p. ] : ill

## **Characterization of deep level traps in semiconductor structures using numerical experiments**

**Koel, Ants; Rang, Toomas; Rang, Galina** Materials characterization VII 2015 / p. 253-261 : ill

## **Characterization of the temperature dependent behavior of snappy phenomenon by the switching-off of GaAs power diode structures**

**Koel, Ants; Rang, Toomas; Rang, Galina** Heat transfer XIII : simulation and experiments in heat and mass transfer 2014 / p. 439-449 : ill

## **Development and optimisation of modelling methods and algorithms for terahertz range radiation sources based on quantum well heterostructures = Kvantaukudega heterostrukturidel põhinevate terahertsikiirgurite modelleerimismeetodite ja -algoritmide arendus ja optimeerimine**

**Reeder, Reeno** 2014 [https://www.esther.ee/record=b3084247\\*est](https://www.esther.ee/record=b3084247*est)

## **Investigation of deep level centers in i- and n-layers of GaAs pin-diodes**

**Toompuu, Jana; Korolkov, Oleg; Sleptšuk, Natalja; Rang, Toomas** BEC 2014 : 2014 14th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 14th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 6-8, 2014, Tallinn, Estonia 2014 / p. 25-28 : ill

## **Method of samples preparation intended for research of deep centers in i-, n-, and p-layers of GaAs p<sup>+</sup>-pin-n<sup>+</sup> structures and result of analysis**

**Toompuu, Jana; Sleptšuk, Natalja; Korolkov, Oleg; Rang, Toomas** BEC 2016 : 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 15th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 3-5, 2016, Tallinn, Estonia 2016 / p. 35-38 : ill [http://www.esther.ee/record=b2150914\\*est](http://www.esther.ee/record=b2150914*est)

## **Spectral properties of incoherent terahertz torch based on parabolic Ga(As,Bi)/AlGaAs quantum wells**

Karaliunas, Mindaugas; Pagalys, Justas; Jakštė, Vytautas; Norkus, Ričardas; Urbanowicz, Andrzej; Devenson, Jan; Devenson, Renata; **Udal, Andres**; Valušis, Gintaras Terahertz Emitters, Receivers, and Applications X : SPIE Optical Engineering + Applacations, 11-15 August 2019, San Diego, California, United States : proceedings SPIE digital library 2019  
<https://doi.org/10.1117/12.2528428> Conference proceeding at Scopus Article at Scopus Article at WOS

## **Влияние дефектов эпитаксиального слоя на напряжение пробоя высоковольтных арсенид-галлиевых структур**

Aškinazi, G.; Zolotarevskaia, O.; **Meiler, Boriss** Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1978 / с. 64-66 : илл  
[https://www.esther.ee/record=b1262177\\*est](https://www.esther.ee/record=b1262177*est)

## **Влияние распределения примеси на прямую ВАХ арсенидгаллиевых силовых диодных структур**

**Velmre, Enn; Freidin, Boris** Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 32-37  
[https://www.esther.ee/record=b1356516\\*est](https://www.esther.ee/record=b1356516*est)

## **Коэффициенное ударное ионизацией носителей заряда в <100> арсениде галлия**

**Rang, Toomas; Puusepp, Märt** Электронная техника. Серия 2, Полупроводниковые приборы : научно-технический сборник 1987 / с. 98-100 [https://www.esther.ee/record=b2160501\\*est](https://www.esther.ee/record=b2160501*est)

## **Межфазное взаимодействие и ориентационные соотношения в системе никель - арсенид галлия**

**Meiler, Boriss** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 3-12

## **Межфазное взаимодействие на контакте Ni-Si и Ni-GaAs**

**Meiler, Boriss** Поверхность : физика, химия, механика 1985 / с. 62-67 : илл [https://www.esther.ee/record=b2149829\\*est](https://www.esther.ee/record=b2149829*est)

## **Неизотермическая динамическая прямая ветвь вольт-амперной характеристики силовых арсенид-галлиевых диодов**

Aškinazi, German; **Velmre, Enn; Logussov, A.; Timofejev, V.; Freidin, Boris; Šumilin, V.** Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics 1984 / с. 48-56 [https://www.esther.ee/record=b1264310\\*est](https://www.esther.ee/record=b1264310*est)

## **Рост и морфология толстых слоев арсенида галлия, выращенных жидкофазной эпитаксией**

**Meiler, Boriss; Zolotarevski, L.; Paat, Aadu; Orenstein, I.** Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1987 / с. 24-26  
[https://www.esther.ee/record=b1262177\\*est](https://www.esther.ee/record=b1262177*est)

## **Сравнение статических параметров диодных структур из GaAs и InP**

**Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris** Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 30-31 [https://www.esther.ee/record=b1310801\\*est](https://www.esther.ee/record=b1310801*est)

**Формирование морфологии и структуры толстых автоэпитаксиальных слоев арсенида галлия при росте из раствора-расплава**

Zolotarevski, L.; Meiler, Boris; Orenštein, I.; Paat, Aadu Технология быстродействующих силовых полупроводниковых приборов : сборник статей 1989 / с. 192-197 : илл [https://www.esther.ee/record=b1267766\\*est](https://www.esther.ee/record=b1267766*est)

**Численное моделирование неизотермических переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах**

Velmre, Enn; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал.

Радиоэлектроника 1984 / с. 86-88 [https://www.esther.ee/record=b2768571\\*est](https://www.esther.ee/record=b2768571*est)

**Численное моделирование переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах**

Velmre, Enn; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал.

Радиоэлектроника 1983 / с. 93-95 [https://www.esther.ee/record=b2768571\\*est](https://www.esther.ee/record=b2768571*est)

**Численный анализ неизотермических переходных процессов в арсенидгаллиевых диодных структурах**

Aškinazi, German; Velmre, Enn; Kivi, U.; Timofejev, V.; Freidin, Boris; Šumilin, V. Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы

докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 15 [https://www.esther.ee/record=b1304403\\*est](https://www.esther.ee/record=b1304403*est)